

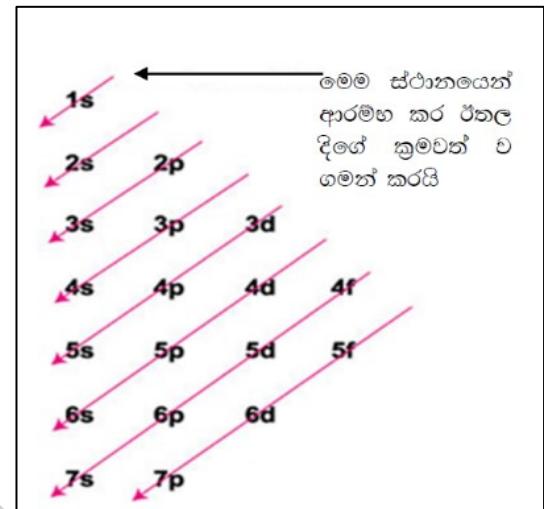
ATOMIC
STRUCTURE
(Part IV)

ඉලෙක්ට්‍රෝන විනයස

පරමාණුවල ඉලෙක්ට්‍රෝන ව්‍යුහය සලකා බලන කළේහ, දෙන ලද n අගයකින් යුත් බහු ඉලෙක්ට්‍රෝන පරමාණුවක, l හි අගය වැඩි වත් ම කාක්ෂිකයක ගක්තිය වැඩි වේ. නිදසුන් ලෙස $n=3$ වන කාක්ෂිකවල ගක්තිය $3s < 3p < 3d$ යන පිළිවෙළින් ආරෝහණය වේ. ඒ අතර හයිඩූල්න් පරමාණුවේ සේ ම, දෙන ලද උපකවචයක සියලු කාක්ෂිකවල (අදා. $3d$ කාක්ෂික පහේ) ගක්තිය සමාන වේ. සමාන ගක්තියන් යුත් කාක්ෂිකවලට පිරිහුණු කාක්ෂික යැයි කියනු ලැබේ.

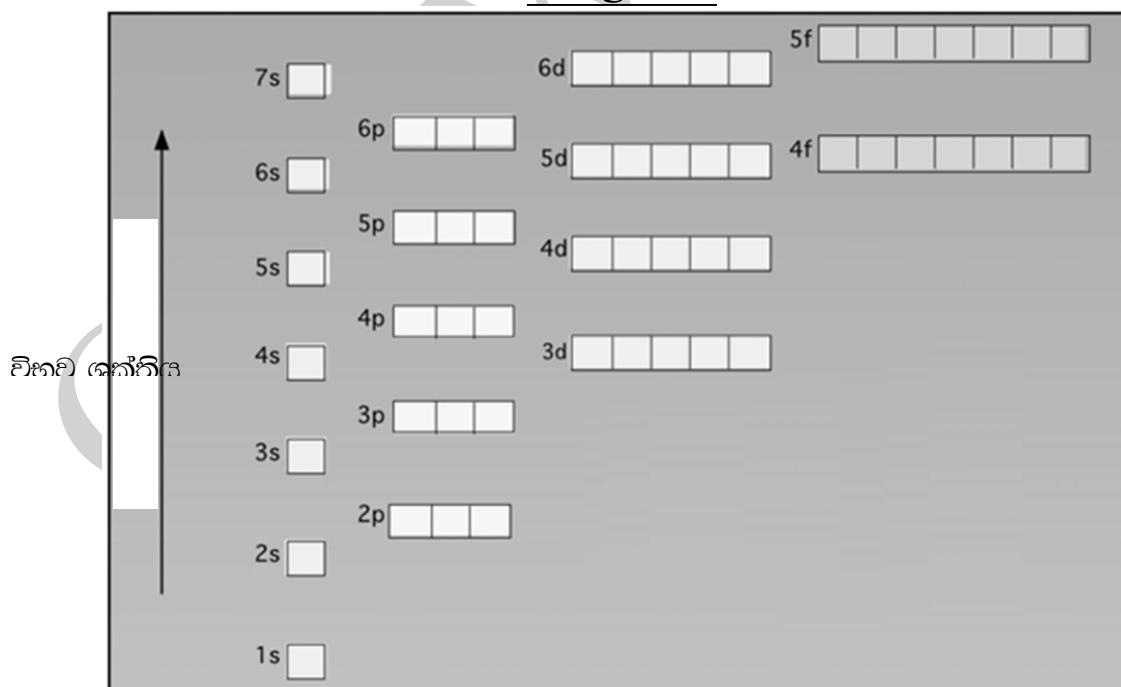
අවුර්බාවු මූලධර්මය

අවුර්බාවු මූලධර්මයට අනුව පර්මාණුවක ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීම ආරම්භ වන්නේ අවම ගක්තියෙන් යුත් උපගක්ති මට්ටමෙනි. අනතුරු ව ගක්තිය ආරෝහණය වන අනුපිළිවෙළට ඉහළ ගක්ති මට්ටමිවලට ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීම සිදු වේ. ('අවුර්බාවු' යන ප්‍රේමන් වචනයෙහි තේරුම තොඩනැගීම' යන්නයි).



ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරීමේ අනුපිළිවෙළ

මේ අනුව ගක්ති මට්ටමිවල හා උප ගක්ති මට්ටමිවල සාමාන්‍ය ගක්ති ආරෝහණ අනුපිළිවෙළ පහත දැක්වෙන පරිදි වේ.



පර්මාණුවක ගක්ති මට්ටම පිහිටන අනුපිළිවෙළ

පච්චල බහිජ්කාර මූලධීමය

1925 දී වොල්ට්ගේ පච්චල විසින් උපග්‍රහණය කිරීමට යෙදුණු පච්චල බහිජ්කාර මූලධීමයෙන් ප්‍රකාශ කෙරේනුයේ යම් පර්මාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දැකකට එක ම ක්වොන්ටම් අංක කුලකයක් (n, l, m_l හෝ m_s) පැවතිය නොහැකි බව ය.

දෙන ලද කාක්ෂීයකට n, l, m_l සහ m_s සඳහා ස්ථාවර අගයක් වේ. එබැවින් පච්චල බහිජ්කාර මූලධීමය තැප්ත වන පරිදි අප විසින් කාක්ෂීයකට එකකට වැඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනක් ඇතුළු කිරීමට අවශ්‍ය නම් එය කළ හැකි එක ම කුමය ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට එකිනෙකට වෙනස් m_s අගයයන් පැවරීමයි. මෙයින් ගම්ජ වන්නේ යම් කාක්ෂීයකට රුවා ගත හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව දැකක් බවත් ඒවායේ බැමුම් එකිනෙකට ප්‍රතිවිරෝධ බවත් ය. මේ සීමා කිරීම නිසා අපට පර්මාණුවක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන, ක්වොන්ටම් අංකවලින් අංකනය කිරීමට අවකාශ ලැබේ.

මෙස් එක් කාක්ෂීයකින් පමණක් සමන්විත s උපකවචයකට උපරිම වගයෙන් දැරිය හැකි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව දැකකි. කාක්ෂීක තුනකින් යුත් p උපකවචයකට උපරිම වගයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන හයක් දැරිය හැකි ය. කාක්ෂීක පහකින් යුත් d උපකවචයකට දැරිය හැකි උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව දහයක්, යනාදි වගයෙනි.

පරමාණුවක විවිධ කාක්ෂීකවල ඉලෙක්ට്രෝන පැතිරේ ඇත්තේ ඒ ඒ කාක්ෂීකවල සාපේශී ගෙනීන් අනුව හා පවිලිගේ බහිජ්කාර මූලධර්මයට අනුව ය.

මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ව්‍යාප්ති පරමාණුවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්යාසය ලෙස හැඳින්වේ. නුම් අවස්ථා යනුවෙන් හැඳින්වෙන වඩාත් ම ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්යාසයේ ද ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතින්නේ ඒවාට තිබිය හැකි අවම ගෙනී තත්ත්වවල ය.

කෙසේ වුව ද පවිලිගේ බහිජ්කාර මූලධර්මය අනුව එක් කාක්ෂීකයක තිබිය යුතු වැඩි ම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන දෙකකි. එබැවින් ගෙනීය වැඩි වන පිළිවෙළින් කාක්ෂීක පිරිම සිදු වන්නේ කාක්ෂීකයකට ඇතුළු වන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව දෙකකට නොවැඩි වන පරිද්‍යෙනි.

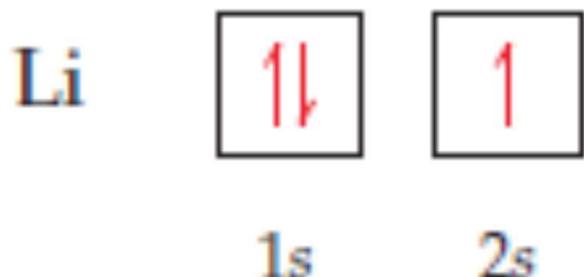
උදාහරණයක් ලෙස ඉලෙක්ට්‍රෝන තුනකින් යුත් ලිතියම් පරමාණුවෙහි, $1s$ කාක්ෂීකයට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දැරිය හැකි ය. තුන් වැනි ඉලෙක්ට්‍රෝනය ඊළග අවම ගෙනී කාක්ෂීකය වන $2s$ කාක්ෂීකයට ගමන් කරයි.

ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරිම සිදු වී ඇති උපකවචයෙහි සංකේතය ලියා, එහි උඩු පෙළ ලෙස එම උපකවචයේ අධිංගු ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව ලිවීමෙන් කිසියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්යාසයක් නිර්පතනාය කළ හැකි ය.

නිදුසුන් ලෙස ලිතියම්වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්යාසය $1s^2 2s^1$ ලෙස ද සෝඩියම්වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්යාසය $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ ලෙස ද අපි ලියමු.

කාක්ෂීක රුපසටහන් නමින් දක්වන තවත් නිරූපණයක දී කාක්ෂීකයක් කොටුවකින් හෝ වෘත්තයකින් ද ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් බාග ඊතලයකින්/ පුරීනා ඊතලයකින් ද දැක්වේ.

ඉහළට යොමු වන අඩ/ පුරීනා ඊතලයෙන් ධන නුමණ වුමිඛක ක්වොන්ටම් අංකයක් ද ($ms = + \frac{1}{2}$) පහළට යොමු වන අඩ/ පුරීනා ඊතලයෙන් සංණා නුමණ වුමිඛක ක්වොන්ටම් අංකයක් ද ($ms = - \frac{1}{2}$) සිංකේතවත් කෙරේ.



ප්‍රතිච්‍රිත නුමණයකින් යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක ම කාක්ෂීකකයේ පවතින විට ඒවා යුග්මික ව ඇතැයි කියනු ලැබේ. ප්‍රතිච්‍රිත නුමණයක් සහිත හවුල්කාර ඉලෙක්ට්‍රෝනයකින් තොර ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් නිර්යුග්මක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් යනුවෙන් හැඳින්වේ. ලිතියම් පරමානුවහි 1s කාක්ෂීකයෙහි ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක යුග්මික වන අතර 2s කාක්ෂීකයෙහි ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනය නිර්යුග්මක වේ.

හුන්ඩි ගේ නීතිය

පිරිග්‍රහු කාක්ෂිකවල ගේතිය අවම වන්නේ සමාන හුමණායකින් යුත් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව උපරිම වන විට බව හුන්ඩි ගේ නීතියෙන් ප්‍රකාශ වේ.

මින් අදහස් වන්නේ හැකි උපරිමයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන තනි තනි ව කාක්ෂිකවලට ඇතුළු වන බවත් දෙන ලද උපකවචක ඇති සියලු තනි ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට එක ම හුමණ ක්වාන්ටම් අංකය ඇති බවත් ය. මේ ආකාරයට සකස් වී ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝනවල බැමීම සමාන්තර යැයි කියනු ලැබේ.

නිදසුන: කාබන් පර්මාණුවහි 2p ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක 2p කාක්ෂික තුනෙන් දෙකක් තනිව අත්පත් කර ගෙන්නා අතර ඒවා බැමීම අතින් සම වන අතර එකිනෙකට සමාන්තර වේ.

දෙවන සහ තුන්වන ආච්‍රිතයේ පිහිටි සැහැල්ල මූලද්‍රව්‍ය
කිහිපයක ඉලෙක්ට්‍රෝන ව්‍යාප්තිය

මූලද්‍රව්‍ය	මුළු ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන	කාක්ෂික සටහන				ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්යාසය
		1s	2s	2p	3s	
Li	3	1↓	1			$1s^2 2s^1$
Be	4	1↓	1↓			$1s^2 2s^1$
B	5	1↓	1↓	1		$1s^2 2s^2 2p^1$
C	6	1↓	1↓	11		$1s^2 2s^2 2p^2$
N	7	1↓	1↓	111		$1s^2 2s^2 2p^3$
Ne	10	1↓	1↓	1111		$1s^2 2s^2 2p^6$
Na	11	1↓	1↓	1111	1	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

සම්පිණ්ඩන ඉලක්ට්‍රෝන විනයාසය

පරමාණුක කුමාංකය 11 වූ සේවීයම්වල ඉලක්ට්‍රෝන විනයාසය (ඉලක්ට්‍රෝන ව්‍යාප්තිය යනුවෙන් ද හඳුන්වේ) $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$ ලෙස ලියනු ලැබේ. කෙසේ වුව ද මෙහි $2p$ උප ගේත් මට්ටම පිරි අවසන් වීමේ දී එම අත් වන්නේ පිටත කවචය ඉලක්ට්‍රෝන අටකින් (අඡ්ටකය) යුත් නියෝන්වල ස්ථායි විනයාසයයි.

ඊළග මූලදුව්‍යය වන සේවීයම්වල දී ආවර්තනා වගුවෙහි නව පේලියක් ඇරඹේ. සේවීයම්වලට නියෝන්වල ස්ථායි විනයාසය ඉක්මවා එක් $3s$ ඉලක්ට්‍රෝනයක් ඇත. එබැවින් සේවීයම්වල ඉලක්ට්‍රෝන විනයාසය සංක්ෂීප්ත ව [Ne] $3s^1$ ලෙස ලිවිය හැකි ය.

මෙහි හතරැස් වර්ගන් තුළ වූ සංක්තයෙන් නිර්පත්‍යය වන්නේ පරමාණුවේ උච්ච වායු හරයයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ අභ්‍යන්තර කවචවල ඇති ඉලක්ට්‍රෝන හඳුන්වෙන්නේ හර ඉලක්ට්‍රෝන යනුවෙහි. උච්ච වායු හරයට පිටතින් ඇති ඉලක්ට්‍රෝන හඳුන්වෙන්නේ බහිර-කවච ඉලක්ට්‍රෝන හෙවත් සංයුත්තා කවච ඉලක්ට්‍රෝන යනුවෙහි.

බාහිර -කවච ඉලක්ට්‍රෝනවලට රසායනික බන්ධන සඳහා සහභාගි වන ඉලක්ට්‍රෝන ද ඇතුළත් වන හෙයින් ඒවා සංයුත්තා ඉලක්ට්‍රෝන යනුවෙන් ද හඳුන්වනු ලැබේ.

මේ ආකාරයට ඉලක්ට්‍රෝන 15කින් යුත් පොස්පරස් $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ හෝ [Ne] $3s^2 3p^3$ ලෙස නිර්පත්‍යය කළ හැකි ය.

නිදසුන

- 14 වැනි මූලද්‍රව්‍යය වන සිලිකන්වල නෑම් අවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ලියන්න.
- නෑම් අවස්ථාවේ ඇති සිලිකන් පරමාණුවක නිර්යුග්මක ඉලෙක්ට්‍රෝන කොපමතා තිබේ ද?

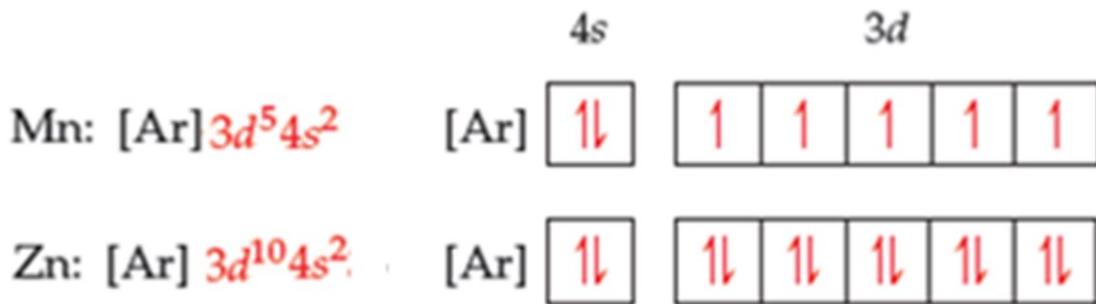
විසඳුම :

a. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ හෝ $[Ne] 3s^2 3p^2$

$1s$	$2s$	$2p$	$3s$	$3p$
1↓	1↓	1↓ 1↓ 1↓	1↓	1 1

- b. නිර්යුග්මක ඉලෙක්ට්‍රෝන දැකකි.

අවුරුධාවු මූලධර්මයට අනුව උච්ච වායු මූලද්‍රව්‍යක් වන ආගන්වලට ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$) පසුව ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරිම සිදු වන්නේ $3d$ කාක්ෂීකයට නොව $4s$ කාක්ෂීකයට ය. එබඳවීන් ආගන්වලට පසුව එන ඊළග මූලද්‍රව්‍යය වන පොට්සියම්වල (K) ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය වන්නේ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ හෙවත් $[Ar]4s^1$ ය. ඉලෙක්ට්‍රෝන 20 ක් ඇති කැල්සියම් හි වින්‍යාසය $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ හෝ $[Ar]4s^2$ වේ. $4s$ කාක්ෂීකය සම්පූර්ණයෙන් පිරිමෙන් ඉක්තිතිව (මෙය කැල්සියම් පරමාණුවහි සිදු වේ.) පිරෙන ඊළග කාක්ෂීක වන්නේ $3d$ ය.



ඒක ඒක කාක්ෂිකයකට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක බැගින් සියලු 3d කාක්ෂික පිරි අවසන් වීමෙන් පසු ඉලෙක්ට්‍රෝන පිරිම සිදු වන්නේ 4p කාක්ෂිකවලට ය. පරමාණුක තුමාංකය 36 වූ තවත් උච්ච වායුවක් වන ක්ලිප්ටොන්හි (Kr) බාහිර ඉලෙක්ට්‍රෝන අභ්‍යකය ($4s^24p^6$) සම්පූර්ණ වන තුරු මෙය සිදු වේයි.

සම්පූර්ණයෙන් පිරිතු නැත හොත් අර්ධ ලෙස පිරිතු, උප ගෙන්ති මට්ටම්වලින් යුත් මූලද්‍රව්‍ය වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන විනයාසවලින් යුත් මූලද්‍රව්‍යවලට සාපේක්ෂව වඩා ස්ථායි බව පෙනෙන්නට තිබේ. එබැවින් s2, p6 හා d10 යන අවසන් විනයාස සහිත මූලද්‍රව්‍ය වඩාත් ස්ථායිවේ.

උදා: Zn; [Ar] $3d^{10}4s^2$, Mg; [Ne] $3s^2$, Ar; [Ne] $3s^23p^6$, N; [He] $2s^22p^3$ හා Mn; [Ar] $3d^54s^2$ සාපේක්ෂව ස්ථායිතාවන් වැඩි විනයාස වේ.

අඟතැම් මූලද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රෝන විනයාසය, ඉහත සාකච්ඡා කරන ලද ඉලෙක්ට්‍රෝන විනයාසයට සම්බන්ධ නීතිවලින් අපගමනය වන බවක් දික්නට ලැබේ. නිදිසුනක් ලෙස කුෂ්මියම් (24) මූලද්‍රව්‍යයෙහි ඉලෙක්ට්‍රෝන විනයාසය අප අපේක්ෂා කරන පරිදි [Ar] $3d^44s^2$ නොව [Ar] $3d^54s^1$ යි.

තව ද කොපර්ටල (29) විනයාසය $[Ar]3d^94s^2$ නොව $[Ar]3d^{10}4s^1$ ය. මේ අසාමාන්‍ය හැසිරීම ප්‍රධාන කොට ම 3d හා 4s කාක්ෂිකවල ගෙන්ති අතර සම්ප බවෙහි ප්‍රතිඵ්‍යුතු කළයේ.

ෂපගෙන්ති මට්ටමක් හරියට ම අර්ධ ව පිරිමට (කුෂ්මියම්වල මෙන්) සහ උපගෙන්ති මට්ටමක් සම්පූර්ණයෙන් පිරිමට ප්‍රමාණුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන තිබෙන විට (කොපර්ටල මෙන්) එහි

ප්‍රතිඵැලය වන්නේ ස්ථායීතාවෙන් සාපේක්ෂව වැඩි විනයාසයකි (3d කාක්ෂික පිරෝන්නේ 4s වලට පසුව බව මතක තබා ගන්න). එහෙත් ඉලෙක්ට්‍රෝන විනයාස ලිවීමේදී බොහෝවිට පළමුව 3d ද පසුව 4s ද ලියනු ලැබේ).

ClassWork.LK

ClassWork.LK